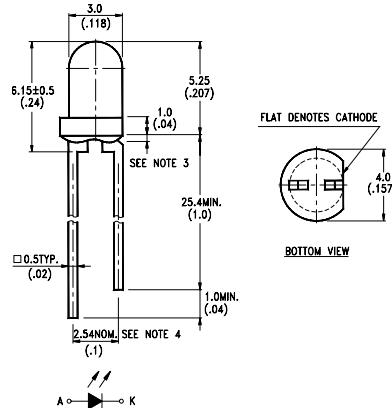


Features

- Selected to specific on-line intensity and radiant intensity ranges.
- Low cost plastic end looking package.
- Mechanically and spectrally matched to the LTR-4206 series of phototransistor.
- The LTE-4206 series are made with Gallium Aluminum Arsenide window layer on Gallium Arsenide infrared emitting diodes.

Description

The LTE-4206 series are high intensity Gallium Aluminum Arsenide infrared emitting diodes mounted in clear plastic end looking packages. The LTE-4206 series provides a broad range of intensity selection. Suffix C-smoke color lens.

Package Dimensions**Notes:**

- All dimensions are in millimeters (inches).
- Tolerance is $\pm 0.25\text{mm}$ (.010") unless otherwise noted.
- Protruded resin under flange is 1.5mm (.059") max.
- Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
- Specifications are subject to change without notice.

Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C

Parameter	Maximum Rating	Unit
Power Dissipation	90	mW
Peak forward Current (300pps, 10 μ s pulse)	1	A
Continuous Forward Current	60	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-40°C to +85°C	
Storage Temperature Range	-55°C to +100°C	
Lead Soldering Temperature [1.6mm (.063 in.) from body]	260°C for 5 Seconds	

Electrical Optical Characteristics at Ta=25°C

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
*Aperture Radiant Incidence	Ee	0.3	0.7		mW/cm ²	I _f =20mA
Radiant Intensity	I _e	2.25	5.26		mW/sr	I _f =20mA
Peak Emission Wavelength	λ Peak		940		nm	I _f =20mA
Spectral Line Half-Width	$\Delta \lambda$		50		nm	I _f =20mA
Forward Voltage	V _F		1.2	1.6	V	I _f =20mA
Reverse Current	I _R			100	μ A	V _R =5V
View Angle (See Fig.6)	2 θ 1/2		20		deg	

Note: *Ee is a measurement of the average radiant incidence upon a sensing area 1cm² in perpendicular to and centered on the mechanical axis of the lens and 26.8mm from lens.

**Typical Electrical/Optical Characteristic Curves
(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)**

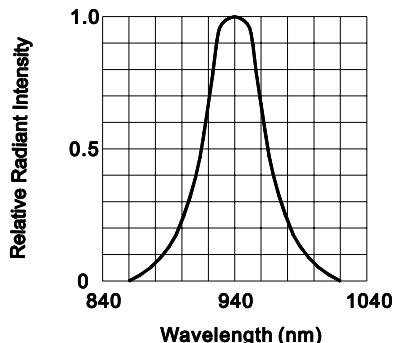
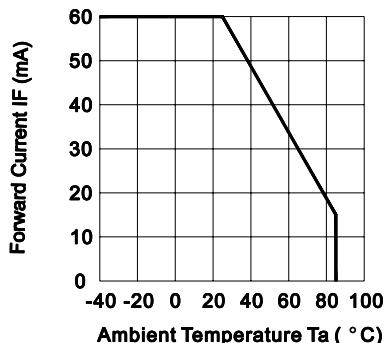
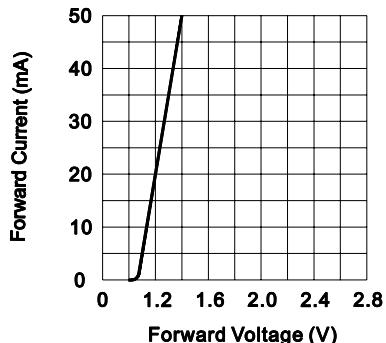


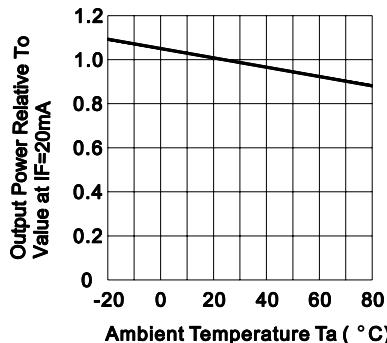
FIG.1 SPECTRAL DISTRIBUTION



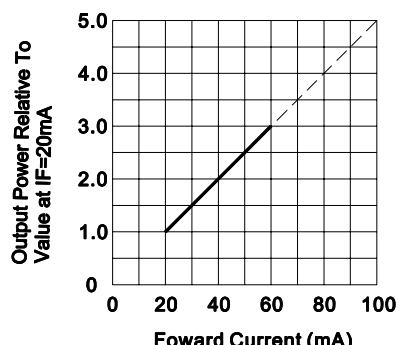
**FIG.2 FORWARD CURRENT VS.
AMBIENT TEMPERATURE**



**FIG.3 FORWARD CURRENT VS.
FORWARD VOLTAGE**



**FIG.4 RELATIVE RADIANT INTENSITY
VS. AMBIENT TEMPERATURE**



**FIG.5 RELATIVE RADIANT INTENSITY
VS. FORWARD CURRENT**

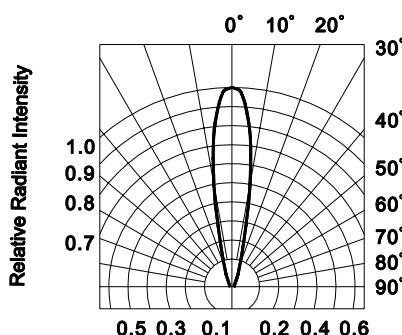


FIG.6 RADIATION DIAGRAM



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.